



# 11930.3-79

Hard-facing materials.  
Method of silicon determination

11930-66  
.4

25.160.20  
1709

21 1979 . 982

01.07.80

( 4—94) 4—93 ,

0,2 10 %)

( -

( , . 2).

1.

— 11930.0—79.

2. ,

-200 , -200 ,

0,0002 .

7 6563—75.

4204—77, 1:4 1:99.

3118—77, 1:1.

4461—77.  
10484—78.

83—79.

7172—76.

( , . 2).

( 2011 .)

1989 . ( 12, 3-85, 3-90)

1984 .,

© , 1979  
© , 2011

3.

3.1

40<sup>3</sup> 0,2 200—300<sup>3</sup>  
 70—100<sup>3</sup> 70—80 ° 10<sup>3</sup>  
 5—8 (60—70 °), 1:99,  
 1000—1100 °  
 2—3 3—5<sup>3</sup> 1000—1100 °  
 900—950 ° 650—700 ° 200<sup>3</sup>  
 ( 1,2).  
 3.2.

1, 200—300<sup>3</sup>  
 50<sup>3</sup> 1:4.  
 1<sup>3</sup> 3.1.  
 750—800 °

1

, %		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (1 : 4)
0,2	2	60
2	3	50
3	4,5	40
4,5	6	40
6	10	40

( 2).  
 3.3. ( 2).

4.

4.1.

(X)

$$\frac{m}{V} = \frac{m_i}{V_i} \cdot 0,4672 \cdot 100$$

— ; ;  
 1 — ; ;  
 2 — ; ;  
 — ; ;  
 V — ; ;  
 V<sub>i</sub> — ; ;  
 — ; ;  
 0,4672 —

4.2.

= 0,95

, .2.

2

, %	, %	, %
0,20 - 1,00	0,05	0,10
. 1,00 » 2,00 »	0,10	0,15
» 2,00 » 4,50 »	0,15	0,20
» 4,50 » 10,00 »	0,20	0,30

( , . 2).